PTN78020W PTN78020H

JAJS201

6A出力、ワイド入力、出力電圧可変型スイッチング・レギュレータ

特長

Ĭ

TEXAS

NSTRUMENTS www.tij.co.jp

- 6A出力
- 入力電圧範囲:7V~36V/15V~36V
- 出力電圧可変範囲: 2.5V~12.6V/11.85V~22V
- 高効率(最大96%)
- On/Off 制御機能
- 低電圧ロックアウト
- 出力電流制限
- 過熱保護
- 動作温度範囲: -40℃~85℃
- 表面実装パッケージ

アプリケーション

●汎用、産業用制御、HVACシステム、テストおよび 計測、医療機器、AC/DCアダプタ、車両、船舶、 航空

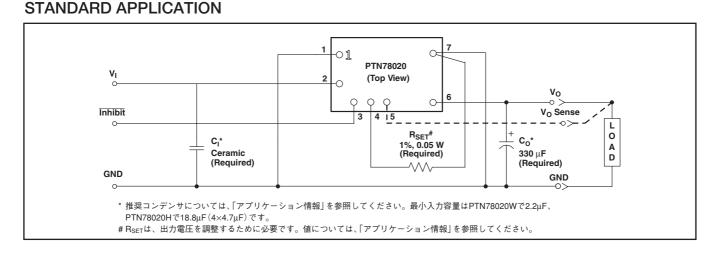


概要

PTN78020は、高効率降圧型統合スイッチング・レギュレータ (ISRS)のシリーズであり、産業分野向け高性能パワー・モジュー ルの進化における第3世代の代表的な製品です。広い入力電圧 に対応しており、12V、24Vまたは28VのDC電力で動作する各 種アプリケーションに適しています。新規設計では、SIP (Single In-line Pin)製品であるPT6620、PT6650、PT6680およびPT6880 シリーズに代わるものと考えてください。PTN78020は前のモ デルに比べて小さく軽い上に、電気的特性については同等また はそれ以上の性能を備えています。ケースレスの両面パッケー ジは熱特性に優れており、RoHSおよび鉛フリー適合のための TIのロードマップに対応しています。

PTN78020は広い入力電圧で動作可能であり、最大6Aの負荷 に対して、高効率の降圧型電圧変換を実現できます。出力電圧 は、1個の外付け抵抗を使用して設定します。PTN78020Wの出 力電圧は2.5V~12.6Vの範囲、PTN78020Hの出力電圧は11.85V~ 22Vの範囲の任意の値に設定できます。PTN78020Wの出力電圧 は入力から2V以上の降圧が可能で、7Vに対する降圧動作で5V の電圧を出力できます。また、PTN78020Hの出力電圧は、入 力から3V以上の降圧が可能で、15Vに対する降圧動作で12Vの 電圧を出力できます。

PTN78020には、低電圧ロックアウト機能、内蔵のon/off制 御機能、出力電流制限機能および過熱保護機能があります。



この資料は、Texas Instruments Incorporated (TI)が英文で記述した資料 を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス・インスツルメンツ (日本TI)が英文から和文へ翻訳して作成したものです。 資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。 日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補 助的参考資料としてご使用下さい。

助的参考資料としてご使用下さい。 製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料を ご確認下さい。



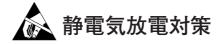
SLTS228A 翻訳版

最新の英語版資料 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ptn78020w.pdf

TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわ らず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如 何なる責任も負いません。

オーダー情報

最新のパッケージおよびご発注情報については、このデータ シートの巻末にある「付録:パッケージ・オプション」を参照す るか、www.ti.com、またはwww.tij.co.jpにあるTIのWebサイト を参照してください。



これらのデバイスは、限定的な ESD (静電破壊) 保護機能を 内蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOS ゲートに 対する静電破壊を防止するために、リード線どうしを短絡して おくか、デバイスを伝導性のフォームに入れる必要があります。

絶対最大定格⁽¹⁾

動作温度範囲内(特に記述のない限り)すべての電圧はGNDを基準

			単位	
T _A	Operating free-air temperature	Over V _I range		-40°C to 85°C
	Wave solder temperature	Surface temperature of module body or pins (5seconds)		
	Solder reflow temperature	Surface temperature of module body or pins	Horizontal SMD (suffix AS)	235°C
	Solder renow temperature	Surface temperature of module body of pins	Horizontal SMD (suffix AZ)	260°C
Τ _S	Storage temperature			–40°C to 125°C
VI	Input surge voltage, 10 ms maximu	n		38V
V _{INH}	Inhibit (pin 3) input voltage	–0.3V to 5V		
Po	Output power	90W		

(1)絶対最大定格以上のストレスは、致命的なダメージを製品に与えることがあります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの 「推奨動作条件」に示された値を越える状態での本製品の機能動作は含まれていません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与える ことがあります。

推奨動作条件

			MIN	МАХ	単位
V		PTN78020W	7	36	N/
V ₁	Input voltage	PTN78020H	15	36	V
T _A	Operating free-air temperature		-40	85	°C

パッケージ仕様

	PTN78020x (Suffix AH, AS, & AZ)						
Weight			7.3 grams				
Flammability	Meets UL 94 V-O						
Mechanical	Per Mil-STD-883D, Method 2002.3, 1ms, 1/2 sine,	Horizontal T/H (suffix AH)	250G ⁽¹⁾				
shock	mounted	Horizontal SMD (suffix AS and AZ)	125G ⁽¹⁾				
Mechanical		Horizontal T/H (suffix AH)	20G ⁽¹⁾				
vibration	Mil-STD-883D, Method 2007.2, 20-2000Hz	Horizontal SMD (suffix AS and AZ)	10G ⁽¹⁾				

(1) 条件制限あり。



電気的特性

周囲温度25℃、V_I = 20V、V₀ = 5V、I₀ = I₀(最大)、C_I = 2.2µF、C₀ = 330µFにおける動作(特に記述のない限り)

	パラメータ	テスト条件			PTN78	3020W		
	193-3	テスト条件		MIN	ТҮР	MAX	単	位
			$V_l \le 24V$	0.1		6 ⁽¹⁾		
0	Output current	$T_A = 25^{\circ}C$, natural convection airflow	V _I = 32V	0.1		5 (1)		А
			$V_I = 36V$	0.1		4.5 ⁽¹⁾		
VI	Input voltage range	Over I _O range		7 (2)		36 ⁽³⁾		V
	Set-point voltage tolerance	$T_A = 25^{\circ}C$				±2% ⁽⁴⁾		
	Temperature variation	−40°C to +85°C			±0.5%			
Vo	Line regulation	Over V _I range			±10		1	mV
•0	Load regulation	Over I _O range			±10		1	mV
	Total output voltage variation	Includes set point, line, load $-40 < T_A < 85^{\circ}C$				±3% ⁽⁴⁾		
			V _I < 12V	2.5		V ₁ -2		
		121	$V \le V_I \le 15.1V$	2.5		$V_{I} - 2.5$		• •
V _O (adj)	(adj) Output voltage adjust range	15.1	2.5		12.6	V		
			V ₁ > 25V					
		V _I = 24V, R _{SET} = 732		$0.1 \times V_I$	94%	12.6		
n	Efficiency	Vi= 15V, R _{SET} = 2			88%			
1	,	$V_{I} = 15V, R_{SET} = 78.7k$, -		85%			
	Output voltage ripple	20-MHz bandwith	, ,		1% Vo		V	/ _(PP)
O (LIM)	Current limit threshold	$\Delta V_{\Omega} = -50 \text{ mV}$			8.5			A
- ()		$1A/\mu s$ load step from 50% to 100% l _O max						
	Transient response	R	ecovery time		200			μs
		V _O ove	er/undershoot		5		%	«Vο
		Input high voltage (VIH)		1		Open (5)		
	Inhibit control (pin 3)	Input low voltage (VIL)		-0.1		0.3		V
		Input low current (IIL)			0.25		1	mA
I(stby)	Input standby current	Pin 3 connected to GND			17		1	mA
		V _I increasing			5.5			
UVLO	Undervoltage lockout	V _I decreasing			5.2			V
Fs	Switching frequency	Over V _I and I _O ranges		440	550	660	ŀ	κΗz
CI	External input capacitance	Ceramic and nonceramic		2.2 (6)				μF
		Ceramic				300		
Co	External output capacitance	Nonceramic		330 (7)		2,000		μF
		Equiv. series resistance (nonceramic)		10 (8)			r	mΩ
MTBF	Calculated reliability	Per Telcordia SR-332, 50% stress, $T_A = 40^{\circ}C$, g	round benign	5.6			10	06 H

(1) 入力電圧が24Vを超える場合、最大出力電流は24Vを超える1Vにつき125mAずつディレーティングする必要があります。

(2) 出力電圧が10V未満の場合、最小入力電圧は7Vまたは(Vo+2) Vのうち大きいほうになります。出力電圧が10V以上の場合、最小入力電圧は (Vo+2.5) Vです。 詳細については、「アプリケーション情報」を参照してください。 (3) 出力電圧が3.6V未満の場合、最大入力電圧は(10×V₀) Vです。詳細については、「アプリケーション情報」を参照してください。 (4) 設定ポイント電圧の公差は、R_{SET}の公差と安定性によって影響を受けます。規定された上限は、R_{SET}の公差が1%、なおかつ温度安定性が100ppm/Cまたはそ

れより良好な場合は、無条件で成立します。

(5) この制御ビンは内部でプルアップされています。オープンのままにした場合、モジュールは入力電力が印加されているときに動作します。開放電圧は1.5V (標準値)です。制御用には、漏れ電流の少ない(100nA未満)小さなMOOSFETをお勧めします。詳細については、[アプリケーション情報]を参照してください。 (6) 正常に動作させるには、入力 (ViおよびGND)の間に2.2μFの外部セラミック・コンデンサが必要です。コンデンサはモジュールに近接させて配置します。 (7) 正常に動作させるには、330μFの出力側コンデンサが必要です。詳細については、「アプリケーション情報」を参照してください。

(8) これは、すべての電解 (セラミック以外の) コンデンサのESR (標準値) です。ESRの最大値を使用して計算する場合、最小値として17mΩを使用してください。



電気的特性

周囲温度25℃、V_I = 24V、V_O = 12V、I_O = I_O(最大)、C_I = 4 × 4.7µF、C_O = 330µFにおける動作(特に記述のない限り)

	パラメータ	テスト条件		PTN78020H			
	ハフォーダ	テスト余仟		MIN	TYP	MAX	単位
			V _o =12V	0.1		6 (1)	
lo	Output current	$T_A = 25^{\circ}C$, natural convection airflow	V _o = 15V	0.1		6 (1)(2)	A
			V _o = 22V	0.1		4.09 (2)	
VI	Input voltage range	Over I _O range		15 ⁽³⁾		36	V
	Set-point voltage tolerance	$T_A = 25^{\circ}C$				<u>±2%</u> (4)	
	Temperature variation	−40°C to +85°C			±0.5%		
Vo	Line regulation	Over V _I range			±10		mV
•0	Load regulation	Over I _O range			±10		mV
	Total output voltage variation	Includes set point, line, load $-40 < T_A < 85^{\circ}C$				±3% ⁽⁴⁾	
			V _I < 19V	11.85		V1-3	
V _O (adj)	Output voltage adjust range		$19V \leq V_I \leq 25V$	11.85		$V_I - 4$	v
- ()/			V ₁ > 25V	11.85		22	
		V _I = 24V, R _{SET}	= 383kΩ, V _O = 12V		94%		
η	Efficiency	V _I = 24V, R _{SE}	_T = 15kΩ, V _O = 15V		95%		
		V _I = 32V, R _{SET}		96%			
	Output voltage ripple	20-MHz bandwith			1% V _O		V _(PP)
I _{O (LIM)}	Current limit threshold	$\Delta V_0 = -50 \text{mV}$			8.0		A
		1A/µs load step from 50% to 100% I _O max					
	Transient response		Recovery time		200		μs
			V _O over/undershoot		200		mV
		Input high voltage (V _{IH})		1		Open (5)	
	Inhibit control (pin 3)	Input low voltage (VIL)		-0.1		0.3	V
		Input low current (I _{IL})			0.25		mA
I _{I(stby)}	Input standby current	Pin 3 connected to GND			17		mA
		V _I increasing			12.2		
UVLO	Undervoltage lockout	V _I decreasing			12		V
Fs	Switching frequency	Over V _I and I _O ranges		440	550	660	kHz
Cı	External input capacitance	Ceramic and nonceramic		18.8 (6)			μF
		Ceramic		0		300	-
Co	External output capacitance	Nonceramic		330 (7)		2,000	μF
		Equiv. series resistance (nonceramic)		10 (8)			mΩ
MTBF	Calculated reliability	Per Telcordia SR-332, 50% stress, T _A = 40°C,	ground benian	5.6			10 ⁶ Hr

(1) 最大出力電流は、6Aまたは90Wの最大出力電力のうち小さいほうになります。入力電圧が24Vを超える場合、最大出力電流は24Vを超える1Vにつき125mAず つディレーティングする必要があります。詳細については、「代表的特性」を参照してください。

(2) 出力電圧が15Vを超える場合、最大出力電流は1/につき285mAずつディレーティングする必要があります。最大出力電力は90Wです。 詳細については、「アプリケーション情報」を参照してください。

(3) 出力電圧が19V未満の場合、最小入力電圧は15Vまたは(V_O+3) Vのうち大きいほうになります。出力電圧が19V以上の場合、最小入力電圧は(V_O+4) Vです。 詳細については、「アプリケーション情報」を参照してください。

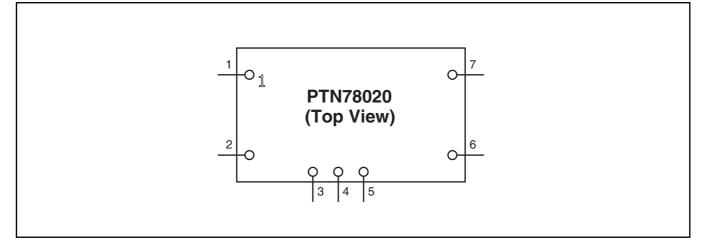
(4) 設定ポイント電圧の公差は、R_{SET}の公差と安定性によって影響を受けます。規定された上限は、R_{SET}の公差が1%、なおかつ温度安定性が100ppm/Cまたはそ れより良好な場合は、無条件で成立します。

(5) この制御ビンは内部でプルアップされています。オープンのままにした場合、モジュールは入力電力が印加されているときに動作します。開放電圧は1.5V (標準値)です。制御用には、漏れ電流の少ない (100nA未満) 小さなMOSFETをお勧めします。詳細については、「アプリケーション情報」を参照してください。 (6) 正常に動作させるには、入力 (V_IおよびGND) の間に4.7µFの外部セラミック・コンデンサが4個必要です。コンデンサはモジュールに近接させて配置します。 (7) 正常に動作させるには、330µFの出力側コンデンサが必要です。詳細については、「アプリケーション情報」を参照してください。

(8) これは、すべての電解 (セラミック以外の) コンデンサのESR (標準値) です。ESRの最大値を使用して計算する場合、最小値として17mΩを使用してください。



ピン配置

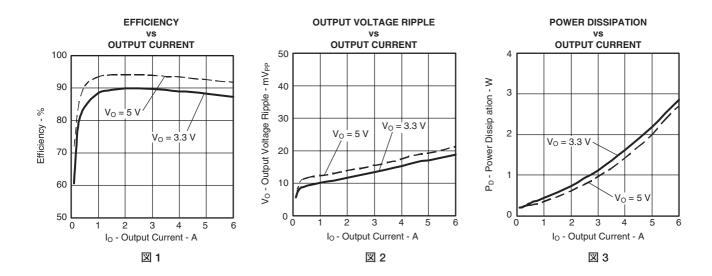


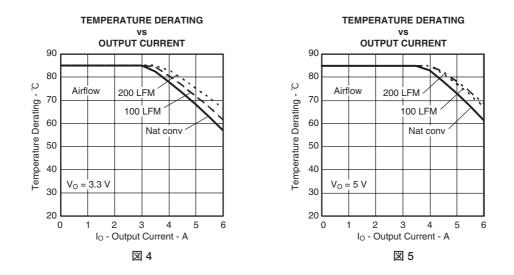
ピンの説明

端子橋	機能	1/0	=× □□
NAME	NO.	I/O	説明
GND	1, 7		VIおよびVoの各電力接続に対するコモン・グランド接続です。また、InhibitおよびVo Adjust制御ピンに対する0V _{dc} の基準でもあります。
VI	2	Ι	モジュールに対する正電圧入力ノード。コモンGNDを基準とします。
Inhibit	3	I	Inhibitピンは、GNDを基準とした、オープン・コレクタ/ドレインのアクティブ・ロー入力です。この入力に 対して"ロー"レベルのグランド信号を印加した場合、モジュールの出力はディスエーブルになり、出力電 圧が0になります。このInhibitによる制御がアクティブになった場合、レギュレータによる入力電流の引き 込みは大幅に減少します。このInhibitピンをオープンのままにした場合、モジュールは有効な入力ソースが 印加されていれるときに常に出力を生成します。
V _O Adjust	4	I	モジュールの出力電圧を設定するには、このピンとGND(ピン7)の間に1%抵抗を接続する必要があります。 オープンのままにした場合、出力電圧はデフォルトの値に設定されます。抵抗の温度安定性は、100ppm/℃ 以内であることが必要です。数種類の一般的な出力電圧に対する抵抗の標準値を「アプリケーション情報」 に示します。
V _O Sense	5	I	Sense入力を使用することで、電圧調整回路によってモジュールと負荷の間の電圧降下を補償できます。 最適な電圧精度を得るには、V _O SenceをV _O に接続する必要があります。センス機能を使用しない場合は、 このピンを接続しません。
Vo	6	0	GNDノードを基準とした、電圧調整後の正電力出力。



代表的特性 (7V入力)⁽¹⁾⁽²⁾

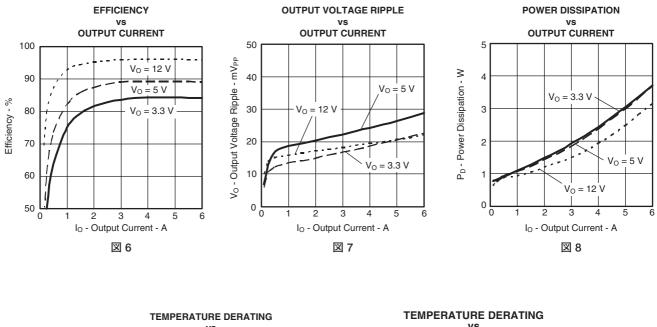


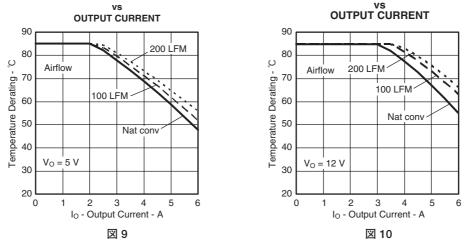


(1) この電気的特性データは、実際の製品を25℃でテストして得られたものです。このデータは、コンバータの代表的なデータと考えられます。図1、図2、および図3に対して適用されます。

(2) 温度ディレーティング曲線は、内部コンポーネントの温度がメーカーの指定した最高動作温度以下になる条件を表します。このディレーティング制限は、2オンス(56.69グラム)の銅を使用した、100mm×100mmの両面PCBに直接半田付けされたモジュールに対して適用します。 表面実装パッケージ(ASおよびAZの各サフィックス)では、電源ピン周囲に熱パスを追加するための複数のビア(メッキされたスルーホール)が必要です。詳細については、メカニカル仕様を参照してください。図4および図5に対して適用されます。





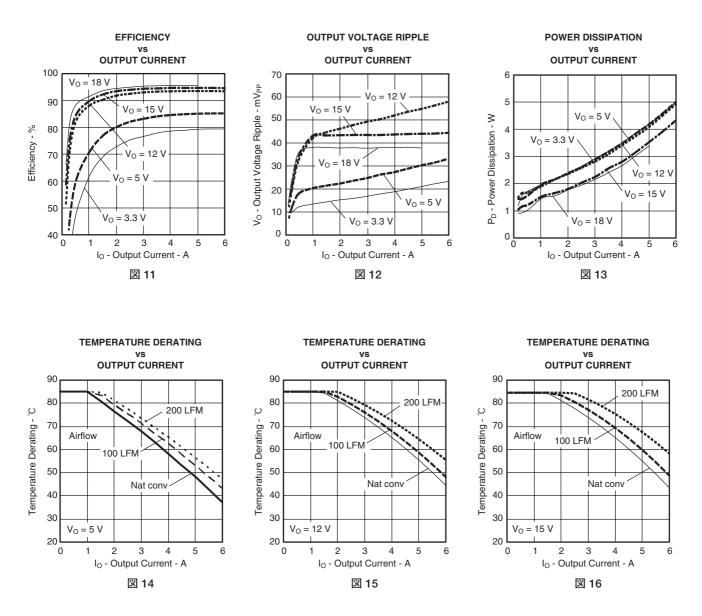


(1) この電気的特性データは、実際の製品を25℃でテストして得られたものです。このデータは、コンバータの代表的なデータと考えられます。図6、図7、および図8に対して適用されます。

(2) 温度ディレーティング曲線は、内部コンポーネントの温度がメーカーの指定した最高動作温度以下になる条件を表します。このディレーティング制限は、2オンス(56.69グラム)の銅を使用した、100mm×100mmの両面PCBに直接半田付けされたモジュールに対して適用します。 表面実装パッケージ(ASおよびAZの各サフィックス)では、電源ピン周囲に熱パスを追加するための複数のビア(メッキされたスルーホール)が必要です。詳細については、メカニカル仕様を参照してください。図9および図10に対して適用されます。



代表的特性 (24V入力)⁽¹⁾⁽²⁾

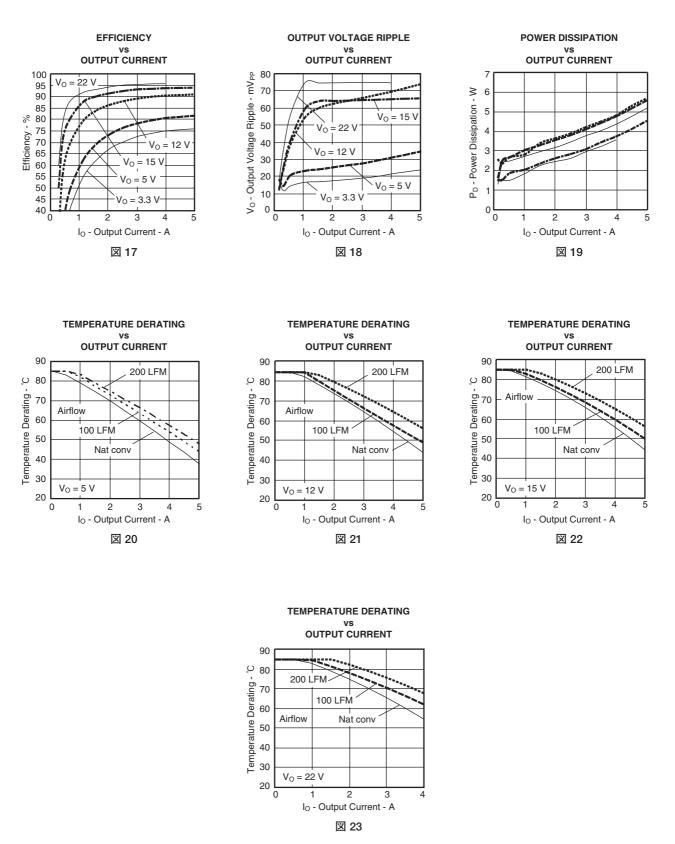


(1) この電気的特性データは、実際の製品を25℃でテストして得られたものです。このデータは、コンバータの代表的なデータと考えられます。図11、図12、および図13に対して適用されます。

(2) 温度ディレーティング曲線は、内部コンポーネントの温度がメーカーの指定した最高動作温度以下になる条件を表します。このディレーティング制限は、2オンス(56.69グラム)の銅を使用した、100mm×100mmの両面PCBに直接半田付けされたモジュールに対して適用します。 表面実装パッケージ(ASおよびAZの各サフィックス)では、電源ピン周囲に熱パスを追加するための複数のビア(メッキされたスルーホール)が必要です。詳細については、メカニカル仕様を参照してください。図14から図16に対して適用されます。



代表的特性 (32V入力)⁽¹⁾⁽²⁾



- (1) この電気的特性データは、実際の製品を25℃でテストして得られたものです。このデータは、コンバータの代表的なデータと考えられます。図17、図18、および図19に対して適用されます。
- (2) 温度ディレーティング曲線は、内部コンポーネントの温度がメーカーの指定した最高動作温度以下になる条件を表します。このディレーティング制限は、2オンス(56.69グラム)の銅を使用した、100mm×100mmの両面PCBに直接半田付けされたモジュールに対して適用します。 表面実装パッケージ(ASおよびAZの各サフィックス)では、電源ピン周囲に熱パスを追加するための複数のビア(メッキされたスルーホール)が必要です。詳細については、メカニカル仕様を参照してください。図20から図23に対して適用されます。



アプリケーション情報

広範囲出力調整型パワー・モジュール PTN78020xシリーズの出力電圧調整

全般

出力電圧を設定するには、 V_0 Adjust制御ピン(ピン4)と GND(ピン1)の間に抵抗を接続する必要があります。PTN78020W の調整可能範囲は2.5V~12.6Vです。PTN78020Hの調整可能範 囲は11.85V~22Vです。ピン4がオープンの場合、出力電圧はデ フォルトで最小値になります。

表2に、標準的な電圧に対する外部抵抗の推奨値、および各値 の場合に得られる実際の出力電圧を示します。その他の出力電 圧に対して必要な抵抗の値は、式1と、表1に示した各製品に対 応する値を使用することによって計算できます。図24は、必要 な抵抗の配置を示しています。

$$R_{SET} = 54.9 \text{ k}\Omega \times \frac{1.25 \text{ V}}{\text{V}_{O} - \text{V}_{min}} - R_{P}$$
 (1)

入力電圧に関する考慮事項

PTN78020は降圧型スイッチング・レギュレータです。出力を レギュレーション状態に保つには、入力電圧が出力電圧を最小 差動電圧分だけ上回っている必要があります。

また、レギュレータ内部制御回路のパルス幅変調 (PWM) 範囲 についても考慮する必要があります。安定動作のためには、そ の動作デューティ・サイクルが一定の最小比率以上である必要 があります。これにより、レギュレータの入力電圧と出力電圧 の最大推奨比率が決定します。

たとえば、十分な性能を得るために、PTN78020xの動作入力 電圧範囲は以下の要件に準拠する必要があります。

- PTN78020Wの出力電圧が10V未満の場合、最小入力電圧は (V₀+2)Vまたは7Vのうち大きいほうになります。
- PTN78020Wの出力電圧が10V以上の場合、最小入力電圧は (V₀+2.5)Vです。
- PTN78020Wの最大入力電圧は(10×V₀)Vまたは36Vのうち小 さいほうになります。
- PTN78020Hの出力電圧が19V未満の場合、最小入力電圧は (V₀+3)Vまたは15Vのうち大きいほうになります。
- 5. PTN78020Hの出力電圧が19V以上の場合、最小入力電圧は (V₀+4)Vです。

表2は、一般的な出力バス電圧に対する動作入力電圧範囲で す。また、「電気的特性」の表には、各入力電圧に対して得られ る出力電圧調整可能範囲が定義されています。

PRODUCT	V _{MIN}	R _P
PTN780x0W	2.5V	6.49kΩ
PTN780x0H	11.824V	6.65kΩ

表1. R_{SET}式の定数

PRODUCT	V _o (Required)	R _{SET} (Standard Value)	V _o (Actual)	Operating V _I Range
	2.5V	Open	2.5V	7V to 25V
PTN780x0W	3.3V	78.7kΩ	3.306V	7V to 33V
	5V	21kΩ	4.996V	7V to 36V
	12V	732Ω	12.002V	14.5V to 36V
	12V	383kΩ	12.000V	15V to 36V
PTN780x0H	15V	15kΩ	14.994V	18V to 36V
	18V	4.42kΩ	18.023V	21V to 36V
	22V	95.3	21.998V	26V to 36V

表2. 一般的な出力電圧に対応するRsetの標準的な値



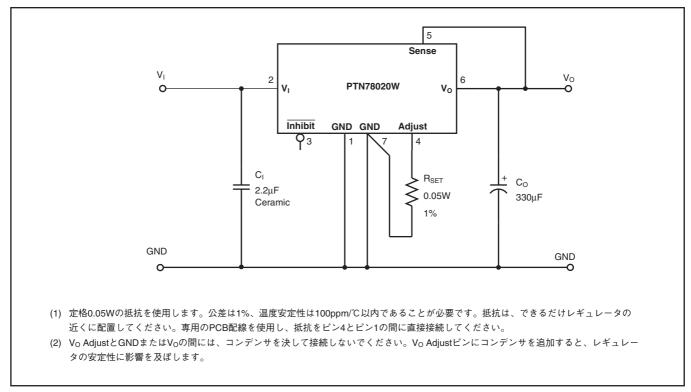


図24. PTN78020WにおけるVo Adjust抵抗の配置

V ₀ (V)	R _{SET} (kW)	V ₀ (V)	R _{SET} (kW)	V _o (V)	R _{SET} (kW)	V ₀ (V)	R _{SET} (kW)
2.50	Open	3.7 V	50.7	6.1	12.6	9.0	4.07
2.55	1370	3.8 V	46	6.2	12.1	9.2	3.75
2.60	680	3.9 V	42.5	6.3	11.6	9.4	3.46
2.65	451	4.0 V	39.3	6.4	11.1	9.6	3.18
2.70	337	4.1 V	36.4	6.5	10.7	9.8	2.91
2.75	268	4.2 V	33.9	6.6	10.2	10.0	2.66
2.80	222	4.3 V	31.6	6.7	9.85	10.2	2.42
2.85	190	4.4 V	29.6	6.8	9.47	10.4	2.20
2.90	165	4.5 V	27.8	6.9	9.11	10.6	1.98
2.95	146	4.6 V	26.2	7.0	8.76	10.8	1.78
3.00	131	4.7 V	24.7	7.1	8.43	11.0	1.58
3.05	118	4.8 V	23.3	7.2	8.11	11.2	1.40
3.10	108	4.9 V	22.1	7.3	7.81	11.4	1.22
3.15	99.1	5.0 V	21.0	7.4	7.52	11.6	1.05
3.20	91.5	5.1 V	19.9	7.5	7.24	11.8	0.889
3.25	85.0	5.2 V	18.9	7.6	6.97	12.0	0.734
3.30	79.3	5.3 V	18.0	7.7	6.71	12.2	0.585
3.35	74.2	5.4 V	17.2	7.8	6.46	12.4	0.442
3.40	69.8	5.5 V	16.4	7.9	6.22	12.6	0.305
3.45	65.7	5.6 V	15.6	8.0	5.99		
3.50	62.1	5.7 V	15.0	8.2	5.55		
3.55	58.9	5.8 V	14.3	8.4	5.14		
3.60	55.9	5.9 V	13.7	8.6	4.76		
3.65	53.2	6.0 V	13.1	8.8	4.40		

表3. PTN78020Wにおける出力電圧設定ポイントごとの抵抗値



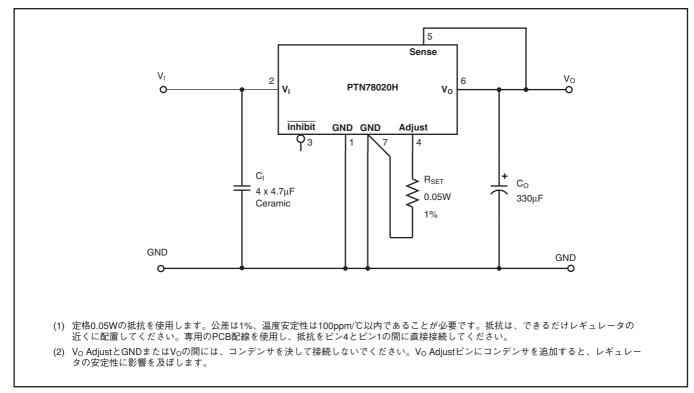


図25. PTN78020HにおけるVo Adjust抵抗の配置

Vo	R _{SET}	Vo	R _{SET}	Vo	R _{SET}
11.85 V	2633 kΩ	13.50 V	34.3 kΩ	17.20 V	6.12 kΩ
11.90 V	896 kΩ	13.65 V	30.9 kΩ	17.40 V	5.66 kΩ
11.95 V	538 kΩ	13.80 V	28.1 kΩ	17.60 V	5.23 kΩ
12.00 V	383 kΩ	13.95 V	25.6 kΩ	17.80 V	4.83 kΩ
12.10 V	242 kΩ	14.10 V	23.5 kΩ	18.00 V	4.46 kΩ
12.15 V	204 kΩ	14.25 V	21.6 kΩ	18.20 V	4.11 kΩ
12.20 V	176 kΩ	14.40 V	19.9 kΩ	18.40 V	3.79 kΩ
12.25 V	154 kΩ	14.55 V	18.5 kΩ	18.60 V	3.48 kΩ
12.30 V	138 kΩ	14.70 V	17.2 kΩ	18.80 V	3.19 kΩ
12.35 V	124 kΩ	14.85 V	16.0 kΩ	19.00 V	2.91 kΩ
12.40 V	113 kΩ	15.00 V	14.9 kΩ	19.20 V	2.65 kΩ
12.45 V	103 kΩ	15.15 V	13.9 kΩ	19.40 V	2.41 kΩ
12.50 V	94.9 kΩ	15.30 V	13.1 kΩ	19.60 V	2.18 kΩ
12.55 V	87.9 kΩ	15.45 V	12.3 kΩ	19.80 V	1.95 kΩ
12.60 V	81.8 kΩ	15.60 V	11.5 kΩ	20.00 V	1.74 kΩ
12.65 V	76.4 kΩ	15.75 V	10.8 kΩ	20.20 V	1.54 kΩ
12.70 V	71.7 kΩ	15.90 V	10.2 kΩ	20.40 V	1.35 kΩ
12.75 V	67.5 kΩ	16.05 V	9.59 kΩ	20.60 V	1.17 kΩ
12.80 V	63.7 kΩ	16.20 V	9.03 kΩ	20.80 V	995 Ω
12.85 V	60.2 kΩ	16.35 V	8.51 kΩ	21.00 V	829 kΩ
12.90 V	57.1 kΩ	16.50 V	8.03 kΩ	21.20 V	669 Ω
12.95 V	54.3 kΩ	16.65 V	7.57 kΩ	21.40 V	516 Ω
13.00 V	51.7 kΩ	16.80 V	7.14 kΩ	21.80 V	229 Ω
13.05 V	49.3 kΩ	17.10 V	6.36 kΩ	22.00 V	94 Ω

表4. PTN78020Hにおける出力電圧設定ポイントごとの抵抗値



PTN78020広範囲出力調整型パワー・ モジュールに対応する推奨コンデンサ

PTN78020Wの入力側コンデンサ

PTN78020Wの入力容量の最小要件は、2.2 μ Fセラミック・コン デンサです。温度特性はX5RまたはX7Rのどちらでもかまいま せん。セラミック・コンデンサは、レギュレータの入力ピンか ら0.5インチ(1.27cm)以内に配置する必要があります。電解 コンデンサを入力側に使用することもできますが、必須のセラ ミック・コンデンサの容量に追加する場合に限定されます。セ ラミック以外のコンデンサ容量の最小リップル電流定格は、 V₀ < 5.5Vにおいて、500mA rms以上である必要があります。 電解コンデンサのリップル電流定格は、電解コンデンサを入力 側において使用する場合の重要な考慮事項です。このリップル 電流要件は、入力側に、最小必要量の2.2 μ Fのコンデンサに加 えて、セラミック・コンデンサを追加配置することにより、減 らすことが可能です。

タンタル・コンデンサは、最小電圧定格2×(最大DC電圧+AC リップル)を満たすものがないため、入力側バスでの使用はお 勧めできません。この電圧定格は、通常のタンタル・コンデン サの信頼性を保証するための標準的な基準です。ポリマー・ タンタル・コンデンサはより信頼性が高く、最大定格20V(標準 値)のものがあります。これらは、最大16Vの入力電圧に対し て使用可能です。。

PTN78020Hの入力側コンデンサ

PTN78020Hの入力容量の最小要件は、18.8 μ F (4 × 4.7 μ F)また は同等のものです。セラミック·コンデンサは、レギュレータ の入力ピンから0.5インチ(1.27cm)以内に配置する必要があり ます。電解コンデンサを入力側に使用することもできますが、 必須のセラミック·コンデンサの容量に追加する場合に限定さ れます。セラミック以外のコンデンサ容量の最小リップル電流 定格は、 $V_0 \leq 5.5$ Vにおいて、500mA rms以上である必要があ ります。 $V_0 > 5.5$ Vにおいては、最小リップル電流定格は 750mA rmsです。電解コンデンサのリップル電流定格は、電 解コンデンサを入力側において使用する場合の重要な考慮事項 です。

タンタル・コンデンサは、最小電圧定格2×(最大DC電圧+AC リップル)を満たすものがないため、入力側バスでの使用はお 勧めできません。この電圧定格は、通常のタンタル・コンデン サの信頼性を保証するための標準的な基準です。ポリマー・ タンタル・コンデンサはより信頼性が高く、最大定格20V(標準 値)のものがあります。これらは、最大16Vの入力電圧に対し て使用可能です。

PTN78020W/PTN78020Hの出力側コンデンサ

安定性を確保するために必要な最小容量は330µFです。セラ ミック・コンデンサと電解コンデンサのどちらでも使用可能で す。セラミック以外のコンデンサ容量の最小リップル電流定格 は、250mA rms以上である必要があります。コンデンサを出力 バス・ピンに近接させて配置しない場合、モジュールの安定性 と電圧公差は保証されません。高品質のコンピュータ用途の電 解コンデンサが最適です。セラミック・コンデンサも、出力ピン から0.5インチ(1.27cm)以内に配置できます。

負荷過渡事象(負荷電流の急激な変化)があるアプリケー ションの場合、コンデンサを追加することでレギュレータの応 答が改善されます。追加する電解コンデンサは、負荷回路に近 接させて配置する必要があります。これらのコンデンサを使用 すると、2kHz~150kHzの周波数範囲にわたってデカップリン グを実現できます。周囲温度が0℃以上の場合は、アルミ電解 コンデンサが適しています。0℃未満での動作の場合は、タン タル・コンデンサまたはOSコン・タイプ・コンデンサをお勧めし ます。セラミック以外のコンデンサを1つまたは複数使用する 場合、計算によって得られる等価ESRが、10mΩ(製造元が示す コンデンサの最大ESRを使用する場合は17mΩ)を下回らないよ うにしてください。コンデンサと製造元の一覧を、表5および 表6(推奨コンデンサの表)に示します。

セラミック・コンデンサ

150kHzを上回る場合、アルミ電解コンデンサのパフォーマン スはあまり効果的になりません。反射入力リップル電流をさら に低減したり、出力過渡応答を改善するには、積層セラミッ ク・コンデンサを追加する必要があります。セラミック・コン デンサのESRは低く、共振周波数はレギュレータの帯域幅を上 回っています。出力側に配置した場合、セラミック・コンデン サの合計容量が300μFを超えない限り、合成ESRは問題になり ません。また、局部共振の発生を防止するため、10μF以上の 同一セラミック・コンデンサを3個以上並列配置しないでくだ さい。



タンタル・コンデンサ

タンタル・タイプのコンデンサは出力側で使用され、動作時 の周囲温度が0℃を下回るアプリケーションの場合に推奨され ます。AVX TPS、Sprague 593D/594/595、およびKemet T495/T510/T520の各コンデンサ・シリーズは、定格サージ、消 費電力、およびリップル電流の性能の面から、他のタンタル・ タイプ・コンデンサよりも推奨されます。もっとも、その他の 多くの汎用タンタル・コンデンサも、非常に高いESR、低い消 費電力、および低いリップル電流を達成しています。ただし、 これらのコンデンサは消費電力とサージ電流の定格が低いた め、信頼性が比較的低くなっています。ESRまたはサージ電流 の定格を明示的に規定していないタンタル・コンデンサは、パ ワー・アプリケーションでは推奨されません。出力側でOSコン またはポリマー・タンタル・コンデンサを指定する場合、最大容 量値に達する前に、ESRの下限に達する場合があります。

コンデンサー覧

表5および表6(コンデンサの表)に、ESRの許容値およびリッ プル電流(rms)の定格など、さまざまな製造元のコンデンサの 特性を示します。コンデンサのタイプごとに、入力バスと出力 バスの両方で必要とされるコンデンサの推奨数を示していま す。この一覧にすべてのコンデンサが記載されているわけでは ありません。他の製造元から供給されている、同等性能のコン デンサも利用できます。一覧のコンデンサは参考として示して います。rms定格とESR(100kHz時)は、レギュレータの性能と コンデンサの長寿命化に関わる重要なパラメータです。

負荷過渡事象を想定した設計

DC/DCコンバータの過渡応答は、di/dtが1A/µsの負荷過渡 事象に基づいて特性化されてきました。この負荷過渡事象に対 する代表的な電圧偏差は、出力側コンデンサに対して必須の値 を使用した、データシート仕様表に記載されています。過渡事 象のdi/dtが増加すると、コンバータの電圧調整回路の応答は、 最終的には出力側コンデンサのデカップリング・ネットワーク に依存するようになります。これは、過渡事象の速度がその帯 域幅の範囲を上回ったときに発生する、あらゆるDC/DCコン バータにとって固有の制約です。ターゲット・アプリケーション がより高いdi/dtまたはより低い電圧偏差を規定している場合、 その要求を満たすには、コンデンサを追加してデカップリング を行う必要があります。この場合、コンデンサの選択において は、コンデンサのタイプ、値、およびESRについて十分に考慮 する必要があります。

		САРА	CITOR CHARACT	ERISTICS		QUA	NTITY	
CAPACITOR VENDOR/ COMPONENT SERIES	WORKING VOLTAGE (V)	VALUE (μF)	EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR) (Ω)	85°C MAXIMUM RIPPLE CURRENT (mArms)	PHYSICAL SIZE (mm)	INPUT BUS	OUTPUT BUS	VENDOR NUMBER
Panasonic FC(Radial)	35	330	0.068	1050	10 × 16	1	1	EEUFC1V331 (V _I < 30 V)
FK (SMD)	50	330	0.12	900	$12,5 \times 13,5$	1 (1)	1	EEVFK1H331Q
United Chemi-Con PXA (SMD)	16	330	0.014	4360	10 × 12,2	1 (1)	≤1	PXA16VC331MJ12TP (V ₁ < 14 V)
PS	16	330	0.014	5500	10 × 12,5	1 (1)	≤ 1	16PS330M J12 (V _I < 14 V)
LXZ	35	220	0.090	760	10 × 12,5	1 (1)	2	LXZ35VB221M10X12LL (V ₁ < 30 V)
MVZ(SMD)	25	470	0.09	670	10 × 10	1	1	$\begin{array}{l} MVZ25VC471MJ10TP\\ (V_{I}<24~V)~(V_{O}\leq5.5~V) \end{array}$
Nichicon UWG (SMD)	35	330	0.15	670	10 × 10	1	1	UWG1V331MNR1GS
SP	20	180	0.032	4280	10×10.5	2 (1)	≤ 2	20SP180M (V _I ~V _O \leq 16 V)
Sanyo Os-Con SVP (SMD)	16	330	0.020	4700	10 × 12,7	1 (1)	≤ 1	$16SVP330M (V_1 \le 14 V)$
SP	20	180	0.032	4280	10×10.5	2 (1)	≤ 2	20SP180M (V _I ≤ 16 V)
AVX Tantalum TPS (SMD)	20	100	0.085	1543	$\begin{array}{c} 7,3 \text{ L} \times 4,3 \\ \text{W} \times 4,1 \text{ H} \end{array}$	N/R ⁽²⁾	≤ 3	TPSV107M020R0085 $(V_0 \le 10 \text{ V})$
AVA Tantaium TPS (SMD)	20	100	0.200	> 817	3225	N/R ⁽²⁾	≤ 3	$\begin{array}{l} TPSE107M020R0200\\ (V_O \leq 10 \ V) \end{array}$

表5. 入力側/出力側の推奨コンデンサ(PTN78020W)

(1) 入力側コンデンサの電圧定格は、レギュレータの動作入力電圧の目的の範囲に応じて選択する必要があります。より高い入力電圧でレギュレータを動作させるには、1つ上のレベルの電圧定格のコンデンサを選択してください。

(2) 推奨されません(N/R)。この電圧定格は、ほとんどのアプリケーションにおいて、動作要件の下限を満たしていません。



	CAPACITOR CHARACTERISTICS						NTITY		
CAPACITOR VENDOR/ COMPONENT SERIES	WORKING VOLTAGE (V)	VALUE (μF)	EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR) (Ω)	85°C MAXIMUM RIPPLE CURRENT (mArms)	PHYSICAL SIZE (mm)	INPUT BUS	OUTPUT BUS	VENDOR NUMBER	
Kemet X5R Ceramic	6.3	47	0.002	>1000	3225	N/R ⁽³⁾	≤ 4	C1210C476K9PAC $(V_0 \le 5.5 V)$	
TDK X5R Ceramic	6.3	47	0.002	>1000	3225	N/R ⁽³⁾	≤ 4	C3225X5R0J476MT (V _O ≤ 5.5 V)	
Murata X5R Ceramic	6.3	47	0.002	>1000	3225	N/R ⁽³⁾	≤ 4	GRM42-2X5R476M6.3 (V _O ≤ 5.5 V)	
Murata X7R Ceramic	50	4.7	0.002	>1000	3225	≥ 1	1	GRM32ER71H475KA88L	
TDK X7R Ceramic	50	2.2	0.002	>1000	3225	≥ 1	1	C3225X7R1H225KT	
TDK X7R Ceramic	25	2.2	0.002	>1000	3225	≥ 1 ⁽⁴⁾	1	C3225X7R1E225KT/MT $(V_I \sim V_O \le 20 \text{ V})$	
Kemet X7R Ceramic	25	2.2	0.002	>1000	3225	≥ 1 ⁽⁴⁾	1	C1210C225K3RAC (V _O ≤ 20 V)	
AVX X7R Ceramic	25	2.2	0.002	>1000	3225	≥ 1 ⁽⁴⁾	1	C12103C225KAT2A (V _O ≤ 20 V)	
TDK X7R Ceramic	50	1.0	0.002	>1000	3225	≥ 2 ⁽⁵⁾	1	C3225X7R1H105KT	
Kemet X7R Ceramic	50	1.0	0.002	>1000	3225	≥ 2 ⁽⁵⁾	1	C1210C105K5RAC	
Kemet Radial Through-hole	50	1.0	0.002	>1000	5,08 × 7,62 × 9,14 H	≥ 2 ⁽⁵⁾	1	C330C105K5R5CA	
Murata Radial Through-hole	50	2.2	0.004	>1000	10 H × 10 W × 4 D	≥ 1	1	RPER71H2R2KK6F03	

表5. 入力側/出力側の推奨コンデンサ(PTN78020W)(続き)

(3) 入力側コンデンサの電圧定格は、レギュレータの動作入力電圧の目的の範囲に応じて選択する必要があります。より高い入力電圧でレギュレータを動作させるには、1つ上のレベルの電圧定格のコンデンサを選択してください。

(4) セラミック・コンデンサの最大定格によって、レギュレータの動作入力電圧が20Vに制限されます。より高い入力電圧で動作させるには、別のセラミック部品 を選択してください。

(5) 1つの2.2µFセラミック・コンデンサの代替として許容されるコンデンサの合計容量は2µFです。



	CAPACITOR CHARACTERISTICS						ANTITY		
CAPACITOR VENDOR/ COMPONENT SERIES	WORKING VOLTAGE (V)	VALUE (μF)	EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR) (Ω)	85°C MAXIMUM RIPPLE CURRENT (mArms)	PHYSICAL SIZE (mm)	INPUT BUS	OUTPUT BUS	VENDOR NUMBER	
Panasonic FC(Radial)	35	330	0.068	1050	10 × 16	1	1	EEUFC1V331 (V _I < 30 V)	
FK (SMD)	50	330	0.12	900	× 13,5	1 ⁽¹⁾	1	EEVFK1H331Q	
LXZ	35	220	0.09	760	10 × 12,5	1 (1)	2	LXZ35VB2231M10X12LL (V _I < 30 V)	
MVY(SMD)	35	220	0.15	670	10 × 10	1	2	MVY35VC221M10X10TP (V _I < 30 V)	
Nichicon UWG (SMD)	35	330	0.15	670	10 × 10	1	1	UWG1V331MNR1GS (V _I < 30 V)	
Sanyo Os-Con SP (SMD	20	180	0.032	4280	10×10.5	2 (1)	≤ 2	20SP180M (V_{I} ~ $V_{O} \le 16 V$)	
TDK X7R Ceramic	25	2.2	0.002	>1000	3225	≥ 8 ⁽²⁾	1	C3225X7R1E225KT/MT ($V_0 \le 20 V$)	
Murata X7R Ceramic	25	2.2	0.002	>1000	3225	≥ 8 ⁽²⁾	1	GRM32RR71E225K (V _O ≤ 20 V)	
Kemet X7R Ceramic	25	2.2	0.002	>1000	3225	≥ 8 ⁽²⁾	1	C1210C225K3RAC (V _O ≤ 20 V)	
AVX X7R Ceramic	25	2.2	0.002	>1000	32225	≥ 8 ⁽²⁾	1	C12103C225KAT2A (V _O ≤ 20 V)	
Murata X7R Ceramic	50	4.7	0.002	>1000	3225	≥ 4	1	GRM32ER71H475KA88L	
TDK X7R Ceramic	50	3.3	0.002	>1000	3225	≥6	1	CKG45NX7R1H335M	
Murata Radial Through-hole	50	3.3	0.004	>1000	12,5 H x 12,5 W x 4 D	≥6	1	RPER71H3R3KK6F03	
Kemet Radial Through-hole	50	4.7	0.002	>1000	5,08 × 7,62 × 9,14 H	≥ 4 ⁽³⁾	1	C350C475K5R5CA	

表6.入力側/出力側の推奨コンデンサ(PTN78020H)

(1) 入力側コンデンサの電圧定格は、レギュレータの動作入力電圧の目的の範囲に応じて選択する必要があります。より高い入力電圧でレギュレータを動作させるには、1つ上のレベルの電圧定格のコンデンサを選択してください。

(2) セラミック・コンデンサの最大定格によって、レギュレータの動作入力電圧が20Vに制限されます。より高い入力電圧で動作させるには、別のセラミック部品 を選択してください。

(3) 1つの2.2µFセラミック・コンデンサの代替として許容されるコンデンサの合計容量は2µFです。

パワーアップ特性

標準的なアプリケーションに従って構成された場合、 PTN78020は、アプリケーションの有効な入力ソース電圧に応 じた調整済み出力電圧を生成します。パワーアップ時に、内部 のソフトスタート回路によって出力電圧の立ち上がりレートが 遅延され、入力ソースからの突入電流量を制限します。ソフト スタート回路によって、パワーアップ特性における短い遅延 (標準値:5ms~10ms)が実現されます。これは、有効な入力 ソースが識別されたポイントから開始されます。図26は、12V の入力電圧で動作し、出力電圧が5Vに調整されたPTN78020W のパワーアップ波形です。波形は、1.5Aの抵抗負荷を使用して 測定したものです。



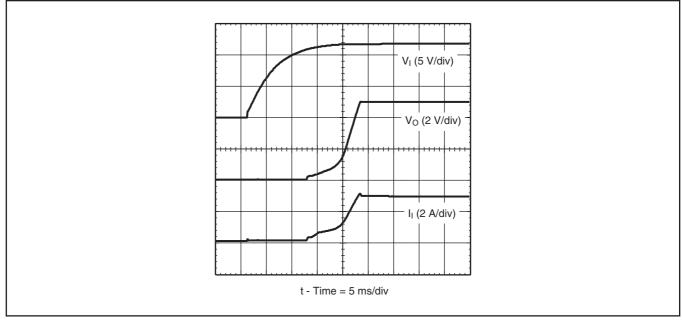


図26.パワーアップ波形

低電圧ロックアウト

低電圧ロックアウト (UVLO) 回路によって、入力電圧が UVLOスレッシュホールドを上回るまで、モジュールのパワー アップが回避されます。これは、パワーアップ時に入力ソース からの過電流がモジュールに流れることを防止するためです。 UVLOスレッシュホールドを下回っている場合、モジュールは オフに維持されます。

電流制限保護

PTN78020モジュールは、継続的な電流制限特性によって、 負荷の異常に対する保護を実現します。負荷異常状態では、出 力電流が電流制限値を超えることはありません。電流制限値を 超える電流が流れそうになると、モジュールの出力電圧が徐々 に低下します。電流は、異常状態が解消するまで継続的に供給 されます。異常状態が解消すると、出力電圧がすぐに回復しま す。出力電流を制限すると、レギュレータの消費電力が増加し、 温度が上昇します。温度が過度に上昇すると、モジュールの過 熱保護機能によって、出力電圧が周期的に完全にオフにされる ようになります。

過熱保護

過熱保護機能により、モジュールの内部回路を過度の高温か ら保護します。温度の上昇は、空気流の減少、高い周囲温度、 持続電流制限条件などが原因として考えられます。内部制御IC の接合部の温度が過度に高くなると、モジュール自体がオフに なり、出力電圧は0になります。温度が数℃下がったことを検 出すると、モジュールはすぐに再起動します。

過熱保護機能は、モジュールの損傷を防止するための最終手 段のメカニズムです。熱ストレスに対する恒常的な保護機能と しては、信頼しないでください。ワーストケース動作条件の出 力電流、周囲温度、および空気流に対する、温度ディレーティン グ制限の範囲内でモジュールを動作させてください。これらの 制限を超えた状態でモジュールを動作させると、たとえ過熱 シャットダウン温度を下回っていても、モジュールの長期的な 信頼性が低下します。



On/Off 制御 (インヒビット) 機能

出力電圧のOn/Off 制御を必要とするアプリケーション用に、 PTN78020パワー・モジュールには出力On/Off 用Inhibit制御ピン (ピン3)があります。この制御(インヒビット)機能は、レギュ レータからの出力電圧をオフにする必要がある状況で使用でき ます。

Inhibitピンをオープンのままにした場合、パワー・モジュー ルは正常動作し、有効なソース電圧がVIに供給されている (GNDを基準として)状況では、調整された出力を提供します。 図27は、On/Off(インヒビット)機能の使用例の回路を示します。 ディスクリート・トランジスタ(Q1)に注目してください。Q1 をオンにすると、Inhibit制御ピンに対して"Low"の電圧が印加 され、モジュールがオフになります。負荷回路によって静電容 量が放電されるため、出力電圧は減衰します。入力で引き込ま れる電流は、17mA(標準値)まで減少します。その後、Q1をオフ にすると、モジュールはソフトスタート・パワーアップを実行 します。20msの間、調整された出力電圧が生成されます。図 28は、Q1をオフにした後の出力電圧の標準的な立ち上がりを 示します。波形Q1 Vgsの立ち下がりが、Q1のオフに対応して います。波形は、1.5Aの抵抗負荷を使用して測定したものです。

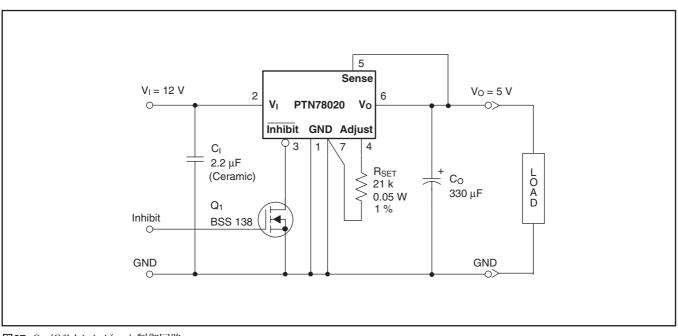


図27. On/Offインヒビット制御回路

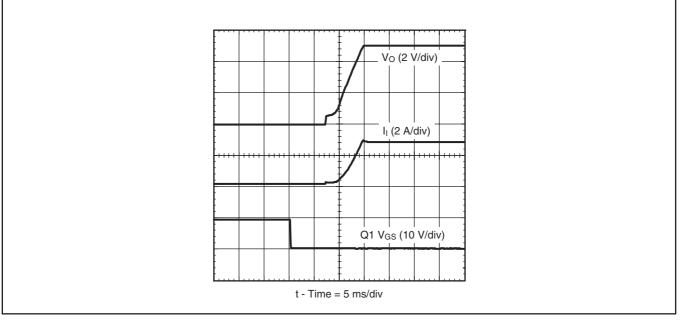


図28. Inhibit制御からのパワーアップ応答



オプションの入出力フィルタ

パワー・モジュールのすべての設計に、内部入出力セラミック・ コンデンサが組み込まれています。しかし、アプリケーション によっては、入力反射または出力リップル/雑音のレベルをよ り低くする必要があります。このアプリケーション情報では、 入力および出力リップル/雑音の両方を適切に減少させるため の各種フィルタおよび設計手法について説明します。

入出力コンデンサ

出力リップルおよび雑音を減らす最も簡単な方法は、図29に 示すC4のような1µFセラミック・コンデンサを1つまたは複数追 加することです。セラミック・コンデンサは、出力電力端子に 近接させて配置する必要があります。1µFコンデンサを1つ追加すると、定格出力電流が3A未満のモジュールでは、出力リッ プル/雑音が10%~30%減少します(注:C3はレギュレータの 過渡応答を向上させるために必要なコンデンサであり、出力 リップルおよび雑音を減少させる効果はありません)。

スイッチング・レギュレータには、その動作周波数のパルス の電流が入力ラインから流れ込みます。発生する反射(入力) リップル/雑音量は、電源の等価ソース・インピーダンス(すべ ての入力ラインのインピーダンスを含む)に正比例します。入 力電力ピンの近くに2.2µF以上のセラミック・コンデンサC1を 追加すると、反射伝導リップル/雑音が30%~50%減少します。

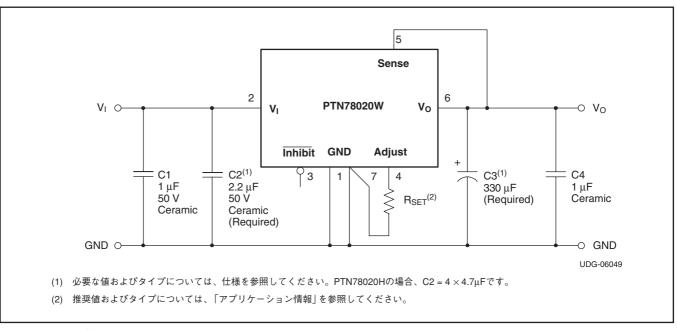


図29. 入力および出力への高周波数バイパス・コンデンサの追加

πフィルタ

アプリケーションにおいて、リップル/雑音レベルをさらに 低下させる必要がある場合は、より高次のフィルタを使用する 必要があります。レギュレータの入力または出力端末にフェラ イト・ビード (Fair-Rite社の品番2773021447または同等品)を直 列接続して使用するπ(パイ)フィルタによって、リップル/雑 音が20db以上減少します (図30および図31を参照してくださ い)。リップルおよび雑音を減らすためにインダクタを効果的 に使用するには、セラミック・コンダクタが必要です(注:製造 元および推奨コンポーネントの詳細については、PTN78020W に対応する「推奨コンデンサ」を参照してください)。 これらのインダクタとセラミック・コンダクタを組み合わせ ることで、スイッチング周波数(650kHz~1MHz)における除 去機能が得られるため、優れたフィルタとなります。このフィ ルタの配置場所は重要であり、入力または出力ピンにできる限 り近接させて配置しなければ、効果がありません。フェライ ト・ビードは小さく(12.5mm×3m)、使いやすく、低コストで あり、DC抵抗が低く抑えられています。Fair-Rite社製の製品 には、表面実装ビード(品番2773021447)や定格5Aのスルー ホール(品番2673000701)もありますが、このアプリケーション では出力バス側に6Aのものを配置するのが効果的です。



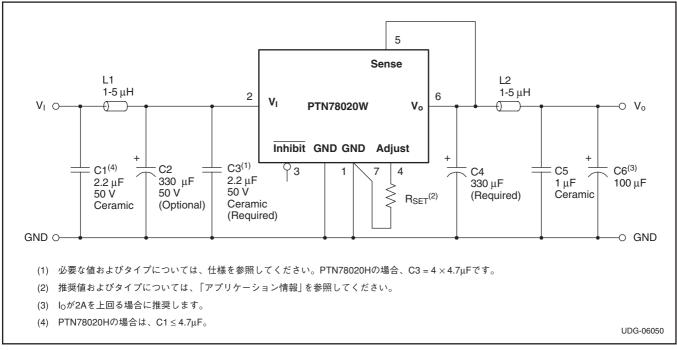


図30. πフィルタの追加(I_O ≤ 3A)

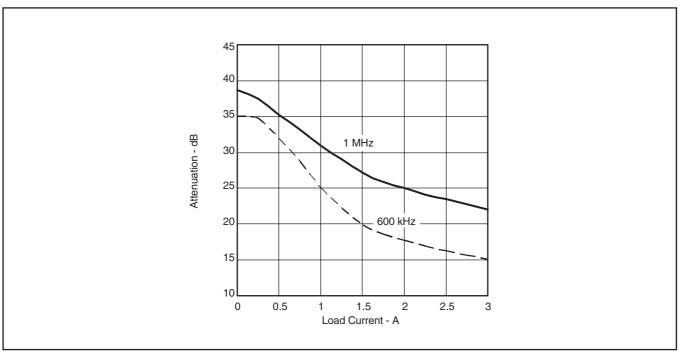
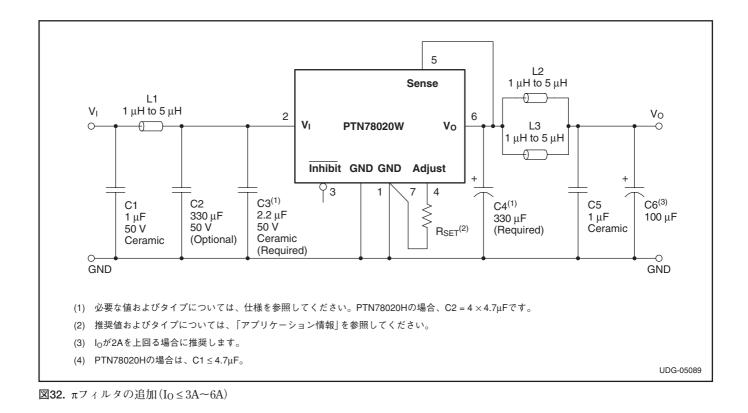


図30. πフィルタの追加(I_O ≤ 3A)







PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status ⁽¹⁾	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan ⁽²⁾	Lead/Ball Finish	MSL Peak Temp ⁽³⁾
PTN78020HAH	ACTIVE	DIP MOD ULE	EUK	7	20	Pb-Free (RoHS)	Call TI	N/A for Pkg Type
PTN78020HAS	ACTIVE	DIP MOD ULE	EUL	7	20	TBD	Call TI	Level-1-235C-UNLIM
PTN78020HAST	ACTIVE	DIP MOD ULE	EUL	7	200	TBD	Call TI	Level-1-235C-UNLIM
PTN78020HAZ	ACTIVE	DIP MOD ULE	EUL	7	20	Pb-Free (RoHS)	Call TI	Level-3-260C-168HR
PTN78020HAZT	ACTIVE	DIP MOD ULE	EUL	7	200	Pb-Free (RoHS)	Call TI	Level-3-260C-168HR
PTN78020WAD	ACTIVE	DIP MOD ULE	EUK	7	20	Pb-Free (RoHS)	Call TI	N/A for Pkg Type
PTN78020WAH	ACTIVE	DIP MOD ULE	EUK	7	20	Pb-Free (RoHS)	Call TI	N/A for Pkg Type
PTN78020WAS	ACTIVE	DIP MOD ULE	EUL	7	20	TBD	Call TI	Level-1-235C-UNLIM
PTN78020WAST	ACTIVE	DIP MOD ULE	EUL	7	200	TBD	Call TI	Level-1-235C-UNLIM
PTN78020WAZ	ACTIVE	DIP MOD ULE	EUL	7	20	Pb-Free (RoHS)	Call TI	Level-3-260C-168 HR
PTN78020WAZT	ACTIVE	DIP MOD ULE	EUL	7	200	Pb-Free (RoHS)	Call TI	Level-3-260C-168 HR

(1) マーケティング・ステータスは次のように定義されています。

ACTIVE:製品デバイスが新規設計用に推奨されています。

LIFEBUY:TIによりデバイスの生産中止予定が発表され、ライフタイム購入期間が有効です。

NRND:新規設計用に推奨されていません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、TIでは新規設計にこの部品を使用することを推奨していません。

PREVIEW:デバイスは発表済みですが、まだ生産が開始されていません。サンプルが提供される場合と、提供されない場合があります。

OBSOLETE:TIによりデバイスの生産が中止されました。

⁽²⁾ エコ・プラン - 環境に配慮した製品分類プランであり、Pb-Free (RoHS)、Pb-Free (RoHS Expert)およびGreen (RoHS & no Sb/Br) があります。最新情報およ び製品内容の詳細については、http://www.ti.com/productcontentでご確認ください。

TBD: Pb-Free/Green変換プランが策定されていません。

Pb-Free (RoHS):TIにおける"Lead-Free"または"Pb-Free"(鉛フリー)は、6つの物質すべてに対して現在のRoHS要件を満たしている半導体製品を意味しま す。これには、同種の材質内で鉛の重量が0.1%を超えないという要件も含まれます。高温で半田付けするように設計されている場合、TIの鉛フリー製品は指定 された鉛フリー・プロセスでの使用に適しています。

Pb-Free (RoHS Exempt):この部品は、1)ダイとパッケージの間に鉛ベースの半田バンプ使用、または 2)ダイとリードフレーム間に鉛ベースの接着剤を使用、 が除外されています。それ以外は上記の様にPb-Free (RoHS)と考えられます。

Green (RoHS & no Sb/Br): TIにおける "Green"は、"Pb-Free"(RoHS互換)に加えて、臭素 (Br) およびアンチモン (Sb) をベースとした難燃材を含まない (均質 な材質中のBrまたはSb重量が0.1%を超えない)ことを意味しています。

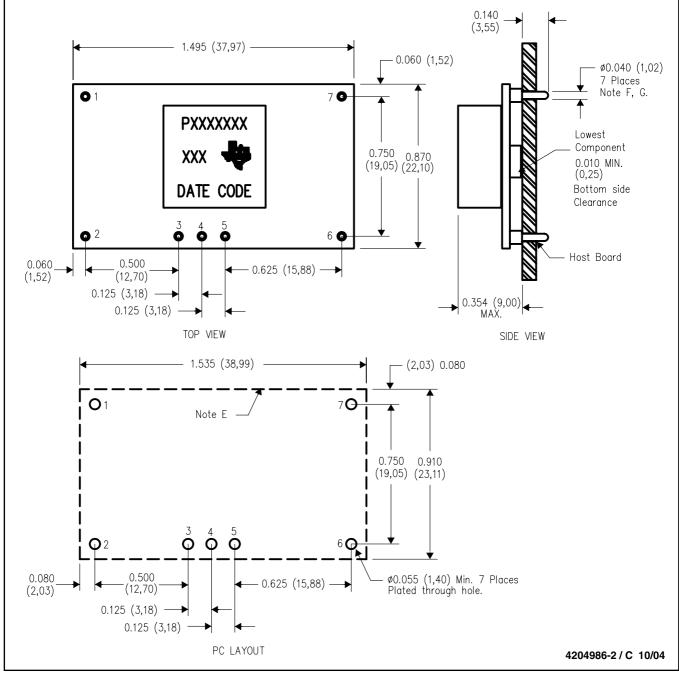
⁽³⁾ MSL、ピーク温度 -- JEDEC業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピーク半田温度です。

重要な情報および免責事項:このページに記載された情報は、記載された日付時点でのTIの知識および見解を表しています。TIの知識および見解は、第三者によって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合するための努力は続けております。TIでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。TIおよびTI製品の供給者は、特定の情報を機密情報として扱っているため、CAS番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。





DOUBLE SIDED MODULE



 注:A. 全ての線寸法の単位はインチ(ミリメートル)です。
B. 図は予告なく変更することがあります。
C. 小数点以下2桁の精度は±0.030(±0.76mm)です。
D. 小数点以下3桁の精度は±0.010(±0.25mm)です。
E. ユーザーのコンポーネントを配置しないことが 推奨されている領域です。 F. ピンの直径は0.040インチ(1.02mm)、隔離ショルダーの 直径は0.070インチ(1.78mm)です。

G. 全てのピンの材質 - 銅合金

仕上げ - ニッケル上に錫 (100%) メッキ



1. 全てのピンの材質 - 銅合金

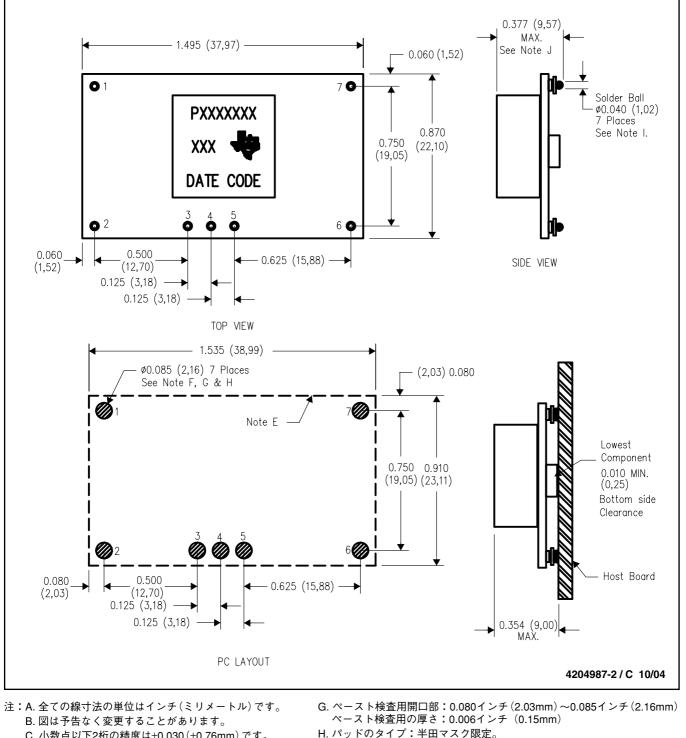
J. 半田リフローの前の寸法です。

仕上げ - ニッケル上に錫(100%)メッキ

半田ボール - 製品データシートを参照。

EUL (R-PDSS-B7)

DOUBLE SIDED MODULE



- C. 小数点以下2桁の精度は±0.030(±0.76mm)です。
- D. 小数点以下3桁の精度は±0.010(±0.25mm)です。
- E. ユーザーのコンポーネントを配置しないことが推奨 されている領域です。
- F. 電源ピンを接続するには、入力ピン、グランド・ ピン、および出力ピン(または電気的な同等要素)が 増えるたびに、内部層にある電源プレーンに対して 内径(I.D.)0.025インチ(0.63mm)のビアを複数使用 する必要があります。

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社(以下TIJといいます)及びTexas Instruments Incorporated(TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます)は、その製品及びサービスを任意に修正し、 改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を 中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最 新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかご 確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取引契約が締結されている場 合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご 注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応 した性能を有していること、またはお客様とTI」との間で合意された保証条件に従 い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびそ の他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行 なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府 がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計につい て責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びその アプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様 の製品及びアプリケーションについて想定されうる危険を最小のものとするため、 適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合せ、機械装置、もしくは 方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的 財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的に も保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報 を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセン スを与えるとか、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を 使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセ ンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づ きTI からライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報 に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付られた全ての保証、条件、 制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情 報に変更を加えて複製することは不公正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そ のような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。 TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパ ラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくは サービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的 保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不公正で誤認を生じさせる行為 です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション(例 えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当 な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの)に使用されることを認めて おりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用に ついて明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情 報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及 び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を 持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致 命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守 する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、 かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないこ とが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表 者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補 償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空 宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図 されておりません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラス テペック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対 応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客 様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは 軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされると いうこと、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされ る全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないこと を認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるよう には設計されていませんし、また使用されることを意図されておりません。但し、TI がISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。 お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使 用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も 負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2009, Texas Instruments Incorporated 日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。 1. 静電気

素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある 場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋 等をして取り扱うこと。

弊社出荷梱包単位(外装から取り出された内装及び個装)又は製品 単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で(導 電性マットにアースをとったもの等)、アースをした作業者が行う こと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。

マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類 は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。

前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置 類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認 されていること。

2. 温·湿度環境

温度:0~40 、相対湿度:40~85%で保管・輸送及び取り扱 いを行うこと。(但し、結露しないこと。) 直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。

- 3 防湿梱包
 - 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装 すること。

4. 機械的衝撃

梱包品(外装、内装、個装)及び製品単品を落下させたり、衝撃を 与えないこと。

5. 熱衝撃

はんだ付け時は、最低限260 以上の高温状態に、10秒以上さら さないこと。(個別推奨条件がある時はそれに従うこと。)

6. 汚染

はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚 染物質(硫黄、塩素等ハロゲン)のある環境で保管・輸送しないこと。 はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。(不純物含有 率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。)